

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成18年6月8日(2006.6.8)

【公表番号】特表2005-527933(P2005-527933A)

【公表日】平成17年9月15日(2005.9.15)

【年通号数】公開・登録公報2005-036

【出願番号】特願2004-509958(P2004-509958)

【国際特許分類】

G 11 C	16/02	(2006.01)
H 01 L	21/8247	(2006.01)
H 01 L	27/115	(2006.01)
H 01 L	29/792	(2006.01)
H 01 L	29/788	(2006.01)
G 11 C	16/06	(2006.01)

【F I】

G 11 C	17/00	6 1 2 E
H 01 L	27/10	4 3 4
H 01 L	29/78	3 7 1
G 11 C	17/00	6 3 3 E

【手続補正書】

【提出日】平成18年4月6日(2006.4.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項52

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項52】

請求項51記載の方法において、

前記結合は容量によって増大されることを特徴とする方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

図1は、従来のフラッシュメモリセル100の断面図を示す。メモリセル100は、基体102、ソース104、制御ゲート108、二酸化シリコン(SiO₂)の絶縁膜100によって電気的に絶縁されたフローティングゲート106、及びドレイン112を有する。従って、メモリセル100は、基本的に、フローティングゲートが付加されたnチャネルトランジスタである。フローティングゲート106に対する電気的アクセスは、フローティングゲート106を囲むSiO₂膜と、ソース104、ドレイン112、チャネル105及び制御ゲート108との間に接続されたキャパシタを通じて行われる。フローティングゲート106に与えられた電荷は、Si-SiO₂における固有のエネルギー障壁によって保持され、これがメモリセルの不揮発性の性質をもたらしている。